

Перв. примен.		Поз. обозначение	Наименование				Кол.	Примечание				
			Устройства									
		A1	VRB4812ZP-6WR3 ф. MORNSUN				1					
		A2	GeoS-5M ф. Geostar				1					
			Преобразователи неэлектрических величин									
Справ. №		BL1	TEM5510FX01				1					
		BL2	APA3010P3BT				1					
			Конденсаторы									
		C1	керам., чип 0603, NPO, 50В, 1нФ ±0.1нФ				1					
		C2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				1					
		C3	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50В, 0.18мкФ ±2%)				1					
		C4	GRM32EC81C476KE15 ф. Murata (керам., чип 1210, X6S, 16В, 47мкФ ±10%)				1					
			47мкФ ±10%)									
		C5	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип C, 16В, 47мкФ ±10%)				1					
		C6	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100В, 470мкФ ±20%, низк. имп.)				1	не старше 1 года				
		C7	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16В, 1000мкФ ±20%)				1					
		C8	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+50...-20)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ ф. АО «Электонд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7В, 100Ф +50...-20%)				1					
		C9-C24	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				58					
Подп. и дата			Микросхемы									
		DA1	МОС3063М (детектор нуля)				1					
		DA2	TPS561201DDC ф. Texas Instruments				1					
			доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2А)									
			доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3А)									
		DA3	LP5907MFX-3.3 ф. Texas Instruments				1					
Подп. и дата							BCAD.123456.001 ПЭЗ					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
		Инв. № подл.		Разраб.	Иванов И.И.			03.07.2025	ВоМ Converter отладочный проект AD			Лит.
Проверил	Петров П.П.				03.07.2025		1	6				
						Перечень элементов			ООО "НИИ БАЦА"			
Н. контр.	Зюзина В.Н.				03.07.2025							
Утв.	Горшков А.С.				03.07.2025							

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание
DD1		SN74LVC1G126DBV ф. Texas Instruments			1	
DD2		SCM3725ASA ф. MORNSUN			1	
DD3		ECS-3225MV-250-CN ф. ECS Inc. (кварц, 25МГц ±25ppm, -40...+85°C)			1	
		Элементы разные				
EF1		SMTS0-M2-2ET ф. PEM (стойка, SMD, M2*0.4, 2мм)			1	
ER1		FK 244 13 D2 PAK ф. Fischer Elektronik			1	
		Устройства защитные				
FP1		MF-MSMF014 ф. Bourns (самовосст., чип 1812, 140мА, 60В)			1	
FU1		0451001. ф. Littelfuse (плавкий, чип 2410, 1А, 0.6029А ² с, быстрый)			1	
FU2		ZH242 (держатель)			1	
FU3		ZH250 (держатель)			1	
FU4		ZH242 (держатель)			1	
FU5		ZH250 (держатель)			1	
FV1		B72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)			1	
FV2		SMBJ6.5CA (супрессор, двуправ., 6.5В, 600Вт [10/1000мкс], корпус SMB)			1	
FV3		SMBJ5.0A (супрессор, одноправ., 5В, 600Вт [10/1000мкс], корпус SMB)			1	
FV4		GSOT05C-E3-08 (супрессор, корпус SOT-23)			1	
FV5		CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23)			1	
		Генераторы, источники питания				
GB1		CR 1/2 AA S PCBD ф. VARTA			1	
GB2		BR-2325/2HAN			1	
GB3		DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, , CR2032)			1	
		доп. замена BH-25F-1 ф. Adam Tech				
		доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices				
GB4		BH-25F-1 ф. Adam Tech (держатель, , CR2032)			1	
		доп. замена DS1092-04-B6P ф. Connfly				
		доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices				
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЭЗ	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Лист
						2

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
		Устройства сигнальные					
HG1		CC56-12SRWA ф. Kingbright			1		
HL1		KP-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)			1		
HL2		KPT-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)			1		
HL3		KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)			1		
HL4		KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)			1		
HL5		KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)			1		
HL6		XPCWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000К, CRI75, 73.9лм [350мА])			1		
HL7		SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)			1		
HL8		KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)			1		
HL9		AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)			1		
J1		Перемычка чип 0402			1		
		Реле					
Подп. и дата		K1 RZ03-1A4-D012 ф. TE Connectivity			1		
		K2 T9GV2L24-12 ф. TE Connectivity			1		
		K3 RT214012 ф. TE Connectivity			1		
		K4 V23105A5476A201 ф. TE Connectivity			1		
Инв. № дубл.							
		Катушки индуктивности					
		L1 чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА			1		
		L2 SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5A)			1		
Взам инв. №		L3-L5 чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА			3		
		L6-L8 SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5A)			3		
		L9, L10 SRN6045TA-2R2Y ф. Bourns (2.2мкГн ±30%, 6A)			2		
		L11 SRR0604-100ML ф. Bourns (10мкГн ±20%, 1.3A)			1		
Подп. и дата		L12 SRN6045TA-2R2Y ф. Bourns (2.2мкГн ±30%, 6A)			1		
		Резисторы					
		R1 чип 0603, 10кОм ±5%			1		
Инв. № подл.							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист
							3

[illegible]

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
		Тиристоры					
VS1					1		
VS2		TYN412RG ф. STMicroelectronics (400В, 12А, 15мА)			1		
VS3		TMMDB3TG ф. STMicroelectronics (двунаправ., 32В, 2А, 15мкА)			1		
VS4		BTA24-600BWRG			1		
		Транзисторы					
VT1		BCR108 (диполярный цифровой)			1		
VT2		IRLML2030			1		
VT3		BC817			1		
VT4		BCR158 (диполярный цифровой)			1		
VT5		IRLML5103			1		
VT6		BC807			1		
VU1		Оптомара LTV-357T			1		
		Соединители					
X1		15EDGRC-3.5-04P ф. Degson			1		
X2		5035000993 ф. Molex			1		
		доп. замена 5035000991					
X3		292303-1 ф. TE Connectivity			1		
		Фильтры					
ZC1		WCM4532F2SF-142T20-HI ф. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.			1		
		(синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А)					
ZF1		MMZ1608B102C ф. TDK (фер. дус., чип 0603, 1кОм ±25% [100МГц],			1		
		600мОм, 300мА)					
ZQ1		FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ppm, фунд., 18пФ,			1		
		1000м, -40...+85°C)					
ZQ2		ABS07-32.768KHZ-T ф. Abracon (кварц., 32.768кГц ±20ppm, 12.5пФ,			1		
		70кОм, -40...+85°C)					
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист
							5
		Изм.	Лист	№ докум.			Подп.

[illegible]